

**关键指标**

频率: 8~12GHz  
 功率增益: 23dB  
 饱和输出功率: 33.5dBm  
 功率效率: 35%  
 电压/静态电流: VD:+8V/640mA, Vg:-0.68V  
 芯片尺寸: 2.85mm×2.05mm

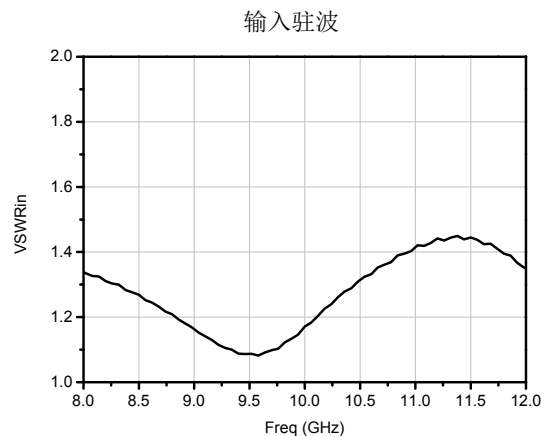
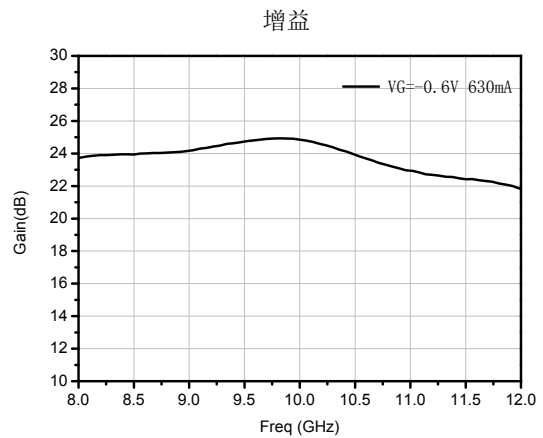
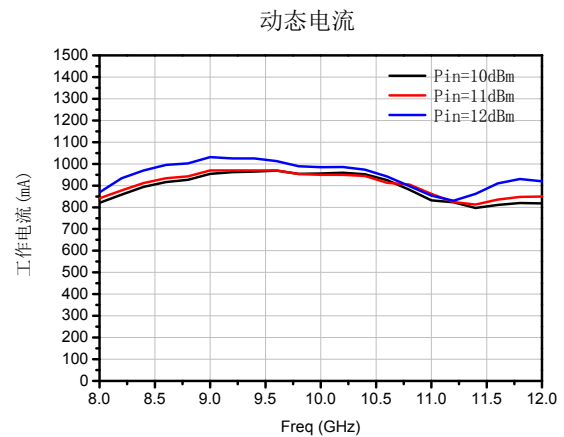
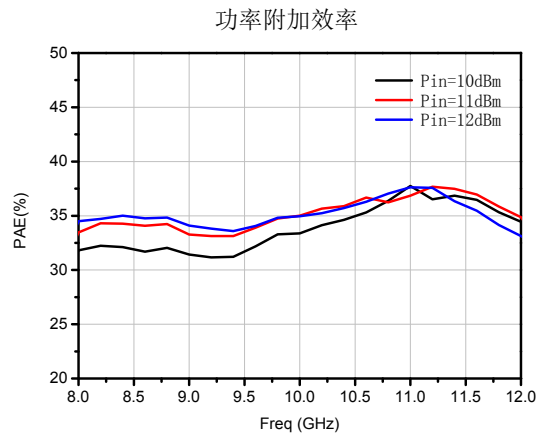
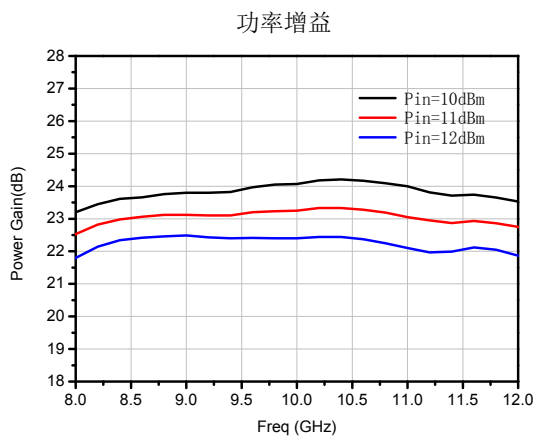
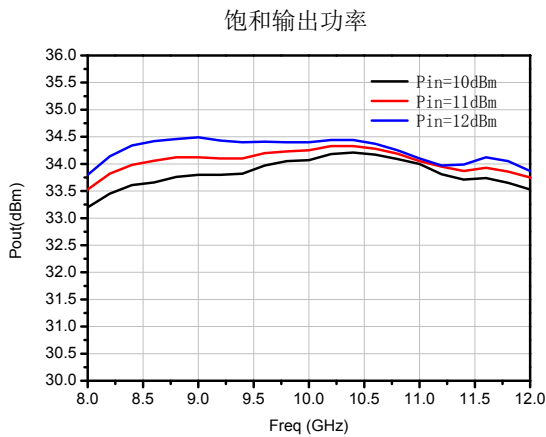
**产品简介**

HG135F8 是一款 X 波段功率放大器芯片, 功率增益为 23dB, 饱和输出功率为 33.5dBm, 采用双电源共电, 正电压为+8V, 静态电流为 640mA, 输入输出端均集成有隔直电容。

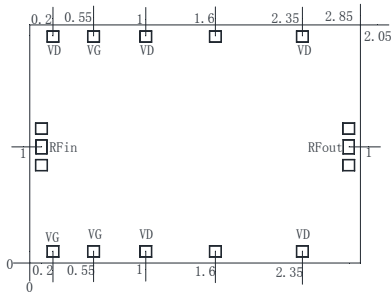
**电性能 (TA=25°C, VD=+8V, Vg=-0.68V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~12		
功率增益(dB)	-	23	-
增益平坦度(dB)	-	±0.5	-
输入驻波	-	1.4	-
饱和输出功率(dBm)	-	33.5	-
效率 (%)	-	35	-
静态电流 (mA)	-	640	-

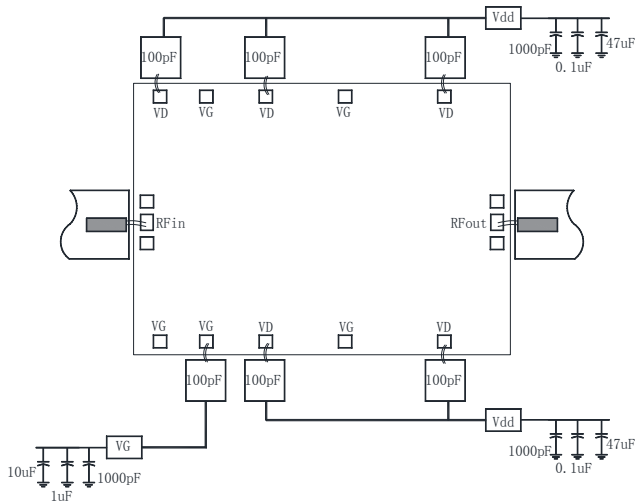
**典型测试曲线**



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+10V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用金锡合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。